东南大学

# 电力电子技术

第10讲

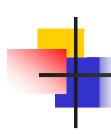
主讲教师: 五念春

380419124@qq. com



# 自关断器件驱动、保护电路

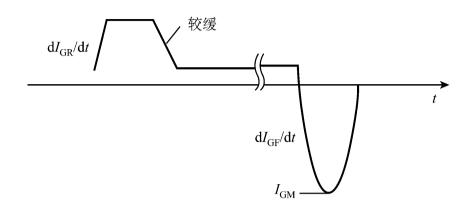


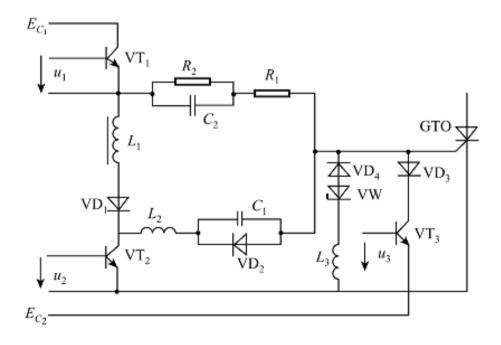


- 二、电流型自关断器件的驱动 1、GTO 的驱动
  - 基本要求

#### 直接耦合式电容储能驱动电路

- (1) 门极开通电路
- (2) 门极关断电路
- (3) 门极反偏电路





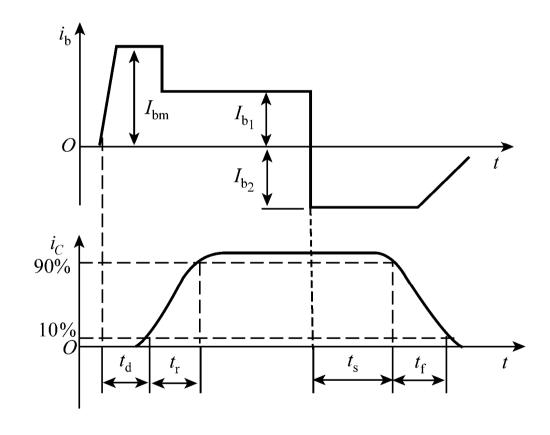




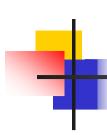


## 2、大功率晶体管的驱动

# (1) 基本要求

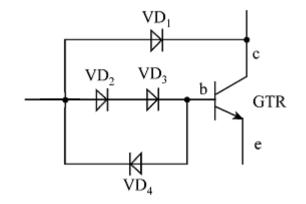






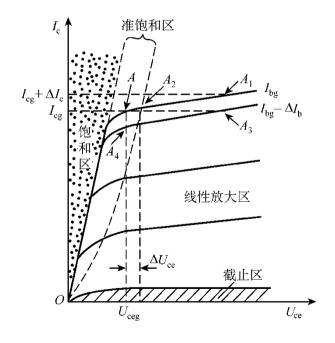
#### (2) 抗饱和电路(贝克钳位电路)

GTR通,如VD<sub>1</sub>正偏 
$$U_{be}+U_{D2}+U_{D3}=U_{ce}+U_{D1}$$
 
$$U_{ce}=U_{be}+U_{D2}+U_{D3}-U_{D1}$$



则:  $U_{ce}=1.4V$ (饱和)

VD<sub>1</sub>:溢流阀作用,过量基流不入基极 变VD<sub>2</sub>, VD<sub>3</sub>数,可变饱和度

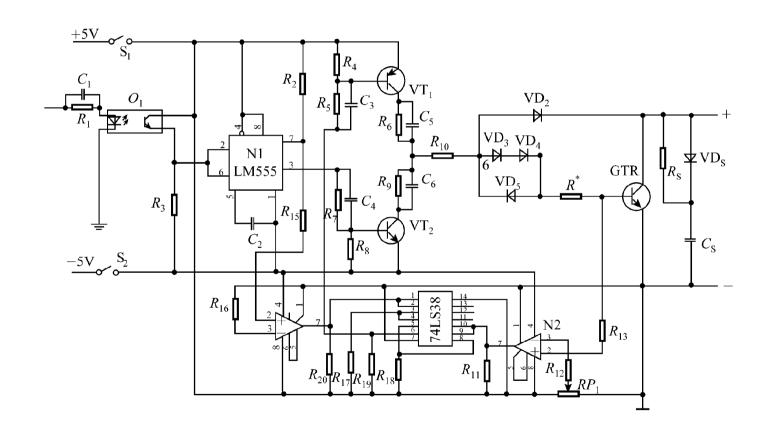






#### (3) 具体驱动电路

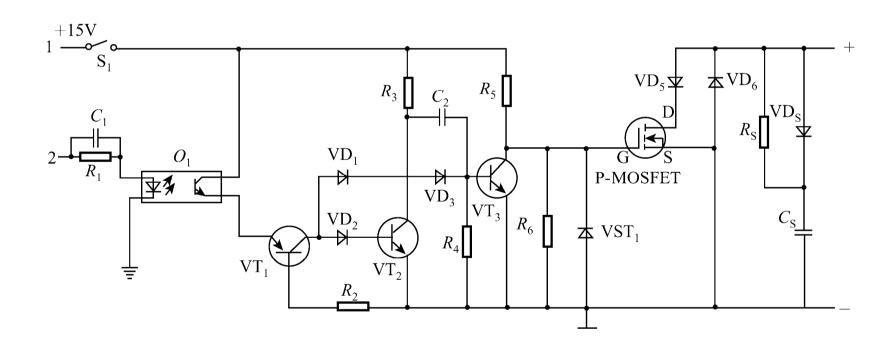
电力电子技术与运动控制技术实验装置







- 三、电压型自关断器件的驱动
  - 1、功率场效应晶体管的驱动
    - (1) 驱动电路

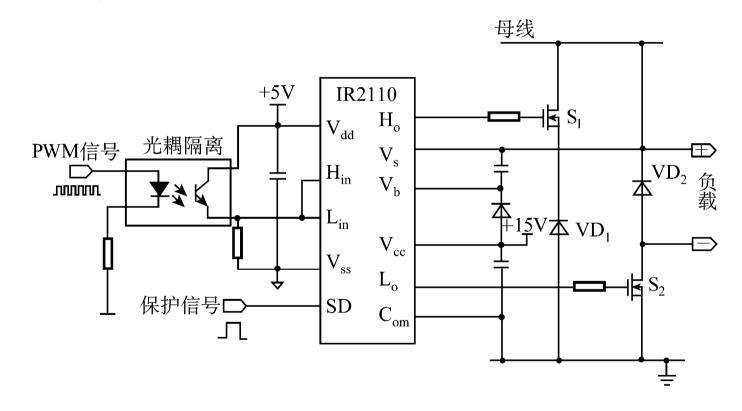




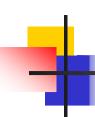


## (2) 专用驱动集成电路

#### IR2110

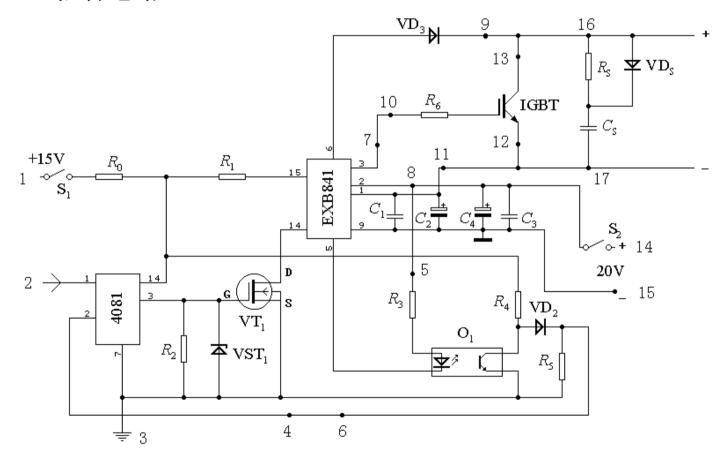




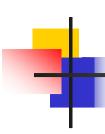


#### 2、绝缘栅双极型晶体管的驱动

#### (1) 驱动电路





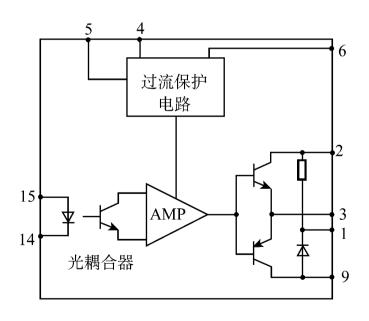


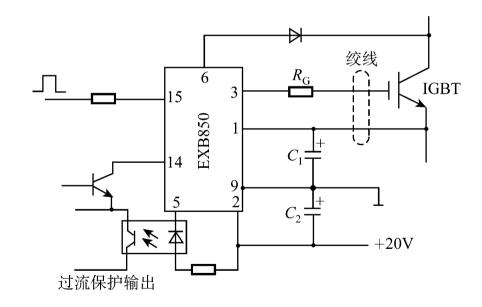
#### (2) 集成栅极驱动电路

EXB系列

标准型: EXB850(851)

高速型: EXB840(841)









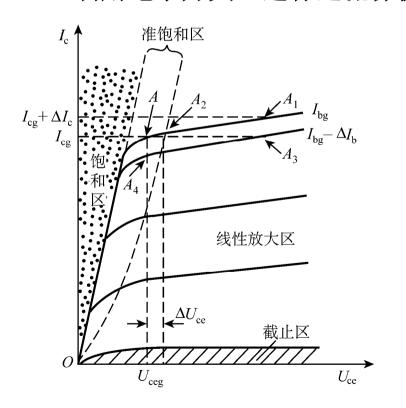


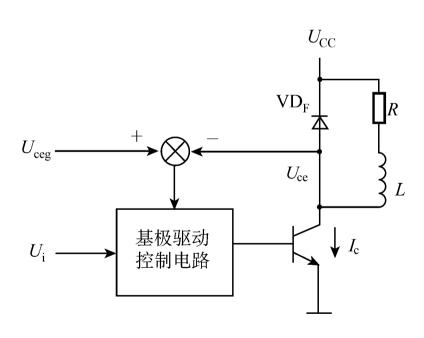
#### 四、自关断器件的保护

- 1、大功率晶体管的保护
  - (1) 过流保护

受冲击能力差,快熔不起作用 利用电子开关,进行过流保护

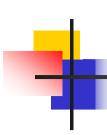
可检测:  $U_{\rm ce}$   $I_{\rm c}$ 











要求工作在临界(准)饱和区,工作点 $\mathbf{A}(U_{\text{ceg}},\ I_{\text{cg}})$ 

测:  $I_{\rm C}$ , 误差 $\Delta I_{\rm C}$ , 到 $I_{\rm C}$ + $\Delta I_{\rm C}$ 才动作

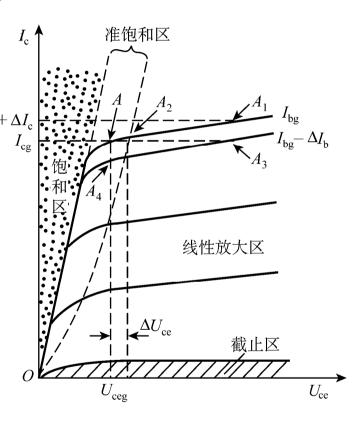
 $A \triangleright A_1$ ,已为放大区

测:
$$U_{ce}$$
:  $DU_{ce}(\frac{DU_{ce}}{U_{ceg}} = \frac{DI_c}{I_{cg}})$   $A \triangleright A_2$ 

如  $I_{\rm b}$ 减少 $\Delta I_{\rm b}$ 

测 $I_c: A \rightarrow A_3$  放大区

测 $U_{ce}$ :  $A \rightarrow A_4$  准饱和区

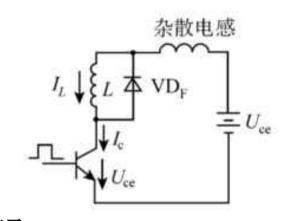


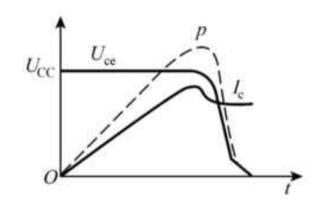






考虑开关过程要经过放大区,需缓冲(吸收)电路。 GTR开通、关断损耗

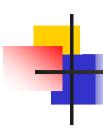




#### 1) 开通

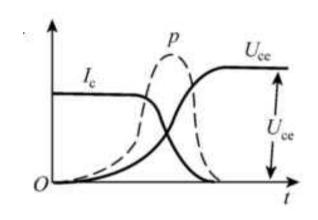
前面关断时, $I_L$ 经 $VD_F$ 续流;开通后由 $VD_F \to GTR$ , $VD_F$ 仍通, $U_{CC}$ 加至GTR,直至 $VD_F$ 断。 出现高电压、大电流

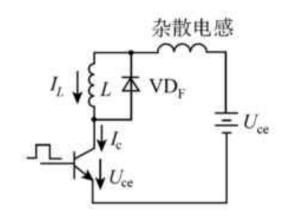




# 2) 关断

电感作用, $I_{\rm C}$ 维持,直至 $U_{\rm ce} \rightarrow U_{\rm CC}$ , ${\rm VD}_{\rm F}$ 通, $I_{\rm c}$ 才下降。

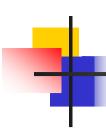




解决方法: 错开高电压、大电流出现时刻





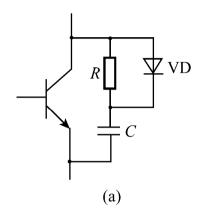


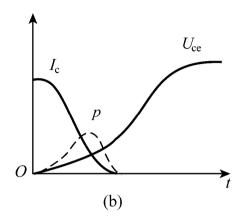
#### 关断吸收:

电容电压不突变, $U_{ce}$ 上升慢

R: 限制GTR通时电容放电

VD: GTR关断时将R短路



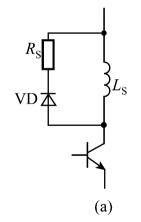


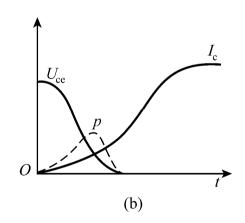
#### 开通吸收:

 $L_{\rm S}$ : 使 $i_{\rm C}$ 上升慢

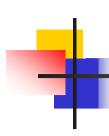
 $R_{S}$ : GTR关断后,续流电流下降

VD: GTR通时,隔离 $R_S$ 旁路作用

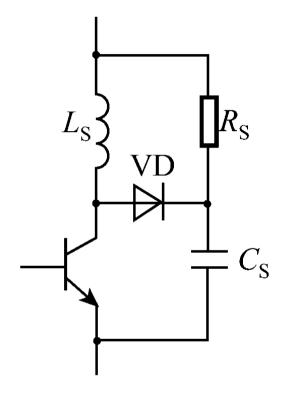








# 复合吸收电路







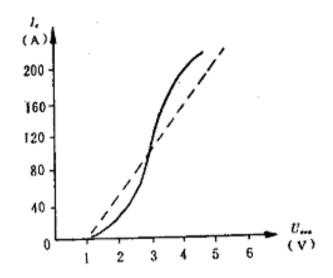
#### 2、IGBT的保护

措施: 检测过流信号,切断栅极控制信号 吸收电路,限  $\frac{du_{ce}}{}$ 

dt

测温

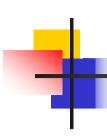
过流保护采用集电极电压判别方法



 $U_{\text{ces}}$ (集电极饱和压降)与 $I_{\text{c}}$ 基本成线性关系

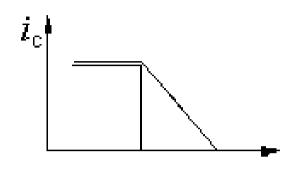






#### 关断时间:

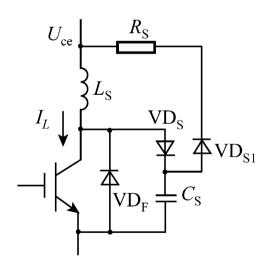
<IGBT允许短路过电流时间 不能太快,di<sub>c</sub>/dt过大,自感电势↑ 慢速过流截止



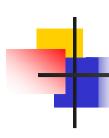
#### 吸收电路:

开通吸收:  $L_{\rm S}$ 、 ${\rm VD}_{\rm S1}$ 、 $R_{\rm S}$ 

关断吸收:  $VD_S$ 、 $C_S$ 







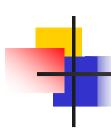
#### P88页 本章小节

#### 本章主要内容:



- (1) 对晶闸管触发电路的基本要求;
- (2) 锯齿波同步触发电路;
- (3) 12钟点法的应用。什么代表电网电压?什么代表晶闸管阳极电压?什么代表触发信号电压?
  - (4) 过电压保护与过电流保护。





# 建议作业:

P. 91 习题 21、22

